

Pressemitteilung

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric entwickelt X-Series New Dual HV IGBT-Modul *Mehr Flexibilität durch Standardgehäuse für Hochleistungs-Halbleitermodul der nächsten Generation*

TOKIO, 6. April 2016 - [Mitsubishi Electric Corporation](#) (TOKYO: 6503) gibt die Entwicklung eines Leistungshalbleitermoduls der nächsten Generation bekannt. Unter der Bezeichnung X-Series New Dual HV IGBT-Modul ist es für Traktions- und Drehstromanwendungen in der Schwerindustrie vorgesehen. Das neue Modul erhöht die Leistungsdichte und Effizienz von Wechselrichtern und ermöglicht durch das Standardgehäuse ein flexibles Design im Aufbau des Wechselrichters.

Ab März 2017 steht die LV100-Version des New Dual-Moduls mit einer Bemessungsspannung von 3,3 kV zum Bemustern zur Verfügung. Ab 2018 steht die HV100-Version mit Bemessungsspannungen von 1,7 kV, 3,3 kV, 4,5 kV und 6,5 kV bereit. Für die Zukunft plant das Unternehmen, die Produktfamilie um eine Version im Bereich unter 1,7 kV zu erweitern.

Der Öffentlichkeit vorgestellt werden die neuen Modelle auf den führenden Fachmessen wie der MOTORTECH JAPAN 2016 im Rahmen der TECHNO-FRONTIER 2016 vom 20. bis 22. April in Japan, der Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2016 vom 10. bis 12. Mai in Nürnberg und der PCIM Asia 2016 vom 28. bis 30. Juni in Shanghai.

Hochleistungs-Module sind die wichtigsten Bauteile zur Regelung der Leistungsumwandlung in elektronischen Systemen. Es gibt sie im Leistungsbereich von einigen Kilowatt bis hin zu mehreren Megawatt. In der Vergangenheit waren Module mit Bemessungsspannungen von bis zu 6,5 kV

und Bemessungsströmen von einigen Tausend Ampere im Handel erhältlich.

Produktmerkmale

Das New Dual HV IGBT-Modul deckt den Bedarf an effizienten Halbleiterbauteilen mit hoher Leistungsdichte für einen großen Leistungsbereich. Die hohe Energieeffizienz und Leistungsdichte wird in den Wechselrichtern durch den Einsatz von IGBTs der 7. Generation erreicht. Sie sind mit CSTBT™-Chips und RFC-Dioden bestückt, die den Leistungsverlust in Wechselrichtersystem auf niedrigem Niveau halten. Die Leistung der Wechselrichter wird durch drei auf dem LV100-Gehäuse befindlichen AC-Hauptanschlüsse erhöht, die die Stromdichte verteilen und ausgleichen. Eine verbesserte Gehäuseteknologie und geringe Parasitärinduktivität sorgen für maximale Leistung.

Das einheitliche Gehäuse der beiden LV100- und HV100-Module ermöglicht vielfältigere Wechselrichterkonfigurationen und -leistungen. Einfache Standard-2in1-Anschlüsse ermöglichen eine optimale Systemauslegung mit Bemessungsleistungen zwischen 1,7 kV/900 A und 6,5 kV/225 A, wodurch die Systemkonfiguration skalierbar und viel flexibler wird.

Durch die standardisierten Gehäuseabmessungen von 100 mm x 140 mm x 40 mm können Industrieelektronik-Hersteller das Design vereinfachen und mehrere Bezugsquellen für ihren Wechselrichter sicherstellen. Zudem ist das neue Standard-Gehäuse mit den Anschlüssen von Infineon Technologies AG kompatibel.

Über Mitsubishi Electric

Seit über 90 Jahren versorgt Mitsubishi Electric Corporation sowohl Unternehmenskunden als auch Endverbraucher auf der ganzen Welt mit qualitativ hochwertigen Produkten aus den Bereichen Informationsverarbeitung und Kommunikation, Weltraumentwicklung und Satellitenkommunikation,

Unterhaltungselektronik, Industrietechnologie, Energie, Transport- und Bauwesen sowie Klima- und Heiztechnik.

Mit rund 135.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen zum Ende des Geschäftsjahrs am 31.03.2016 einen konsolidierten Umsatz von 38,8 Milliarden US Dollar*.

In über 30 Ländern sind Vertriebsbüros, Forschungsunternehmen und Entwicklungszentren sowie Fertigungsstätten zu finden.

Seit 1978 ist Mitsubishi Electric in Deutschland als Niederlassung der Mitsubishi Electric Europe vertreten. Mitsubishi Electric Europe ist eine hundertprozentige Tochter der Mitsubishi Electric Corporation in Tokio.

* Umrechnungskurs 113 Yen = 1 US Dollar, Stand 31.03.2016 (Quelle: Tokyo Foreign Exchange)

Weitere Informationen:

<http://global.mitsubishielectric.com>

<http://www.MitsubishiElectric.de>

<http://www.mitsubishichips.eu>

Pressekontakt Unternehmen:

**Mitsubishi Electric Europe B.V.
Niederlassung Deutschland**

Corinna Meyer

Coordinator Marketing Communications

Mitsubishi-Electric-Platz 1

40882 Ratingen, Germany

www.MitsubishiElectric.de

Tel.: +49 - (0)2102 / 486-5270

Fax: +49 - (0)2102 / 486-4140

corinna.meyer@meg.mee.com